ポリオキソメタレート {Mo_{154/152}} -ring 自己組織化単分子膜の電気伝導

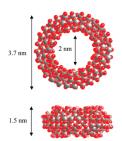
Conductance of Self-assembled monolayer of Polyoxometalate {Mo_{154/152}}-ring 阪大院理¹ ○(M1)後藤 崇浩¹, 村松 拓実¹, 蔡 徳七¹, 松本 卓也¹

Osaka Univ. ¹, ^oTakahiro Goto¹, Takumi Muramatsu¹, Dock-Chil Che¹, Takuya Matsumoto¹ E-mail: gotot19@chem.sci.osaka-u.ac.jp

【はじめに】ポリオキソメタレート(Polyoxometalate, POM)は金属オキソ酸の集合体である。今 回我々はドーナツ型 POM 分子{Mo_{154/152}}-ring に注目した(Figure 1)。{Mo_{154/152}}-ring は基本構造で ある PMo₁₂ が多数集積した構造をもつので[1]、HOMO-LUMO ギャップが小さく、多数の混合原子 価イオンを含むことから、分子素子として優れた電子授受機能が期待される。これまで原子間力 顕微鏡(AFM)を用いた電流-電圧(I-V)測定において、Au(111)表面上に吸着した{Mo154/152}-ring は土 0.5 V に閾値を示すことを報告した。しかし、探針-表面間距離が 1.5 nm 程度と小さいため、電 極間の直接トンネリングの寄与が大きく、弱い非線形特性しか得られなかった[2]。本研究では金 基板と POM の間に 6-アミノ-1-ヘキサンチオール(6-AHT)の単分子膜を導入することで(Figure 2)、 電極間の直接トンネリングを抑制し、{Mo154/152}-ring の分子準位を介した明確な閾値を持つ I-V 特 性を得ることを目的とした。

【実験】マイカ基板に蒸着した Au(111)を塩酸酸性の 6-AHT のエタノール溶液(1 mM)に 24 時 間浸漬した。さらに{Mo_{154/152}}-ring 水溶液(5.0×10⁻⁴M)に1時間浸漬し、窒素気流による乾燥を行 った。窒素雰囲気下の室温において、AFM を用いた点接触 I-V 測定を行った。

【結果と考察】得られた I-V 特性を Figure 3 に示す。ゼロバイアスコンダクタンスはほぼゼロで あり、6-AHT 単分子層の挿入により電極間の直接的なトンネリングが効果的に抑制されたと考え られる。I-V カーブが立ち上がる閾値は約±1 V であり、先に報告した直接接触の場合のおよそ2 倍の値が得られた。6-AHT 単分子層の厚みは約 1 nm であることを考慮すると、{Mo_{154/152}}-ring に かかる実効電界は先の報告と同程度であることがわかる。I-V カーブの非対称性など、詳細につい て検討する。



{Mo_{154/152}}-ring ⊕ NH3 Au mica

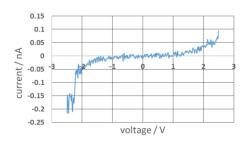


Figure 1. The structure of $\{Mo_{154/152}\}$ -ring [1]

of POM monolayer

Figure 2. Schematic illustration Figure 3. *I-V* curve of {Mo_{154/152}}-ring obtained by AFM

[1] T. Akutagawa, *Langmuir.*, 2008, **24**, 231

[2] H. Matsuo, 表面科学, 2015, **36**, 454-458